

概述

IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是电力控制和电力转换的核心器件,是由BJT(双极型晶体管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,具有高输入阻抗、低导通压降、高速开关特性和低导通状态损耗等特点,在较高频率的大、中功率应用中占据了主导地位。

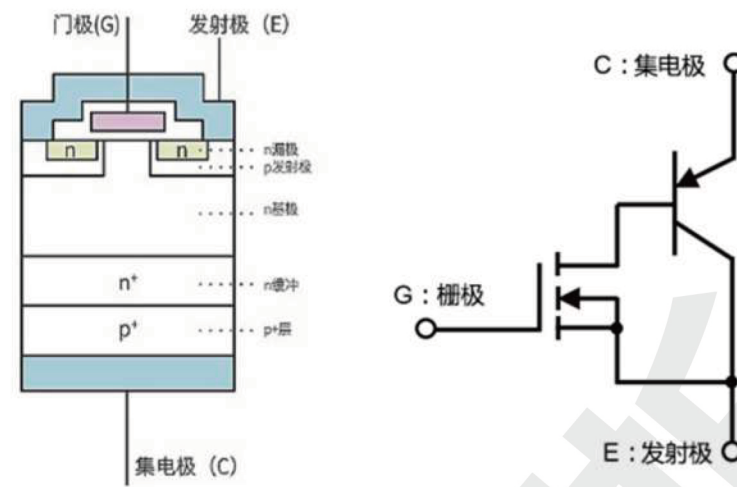


图:IGBT结构与等效电路图

典型参数

集电极-发射极电压 V_{CES}
集电极-发射极击穿电压 $V_{(BR)CES}$
集电极-发射极饱和电压 V_{CEsat}
集电极截止电流 I_{CES}
栅极漏电流 I_{GES}
栅极-发射极电压 V_{GES}
栅极-发射极阈值电压 $V_{GE(th)}$
输入电容, 输出电容, 反向传输电容
续流二极管压降 V_F



扫码关注官方微信



联系销售购买产品

普赛斯IGBT功率半导体器件 静态参数测试解决方案



针对不同封装类型的硅基功率半导体, IGBT、SiC、MOS、GaN等, 提供整套测试夹具解决方案, 可用于TO单管、半桥模组等产品的测试。

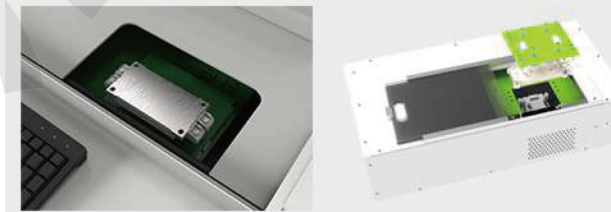


图:夹具安装示意

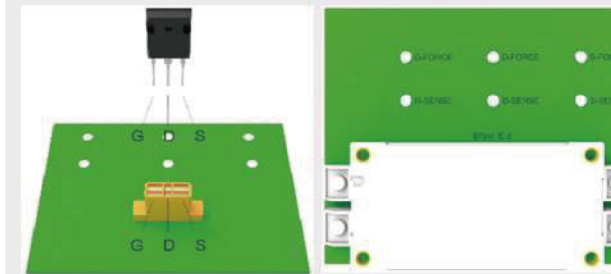


图:不同封装类型夹具

如需了解更多系统搭建方案及测试线路连接指南, 请联系我们!



咨询热线:18140663476